

## 第5章 门电平模型化

本章讲述 Verilog HDL 为门级电路建模的能力，包括可以使用的内置基本门和如何使用它们来进行硬件描述。

### 5.1 内置基本门

Verilog HDL 中提供下列内置基本门：

1) 多输入门：

**and, nand, or, nor, xor, xnor**

2) 多输出门：

**buf, not**

3) 三态门：

**bufif0, bufif1, notif0, notif1**

4) 上拉、下拉电阻：

**pullup, pulldown**

5) MOS 开关：

**cmos, nmos, pmos, rcmos, rnmos, rpms**

6) 双向开关：

**tran, tranif0, tranif1, rtran, rtranif0, rtranif1**

门级逻辑设计描述中可使用具体的门实例语句。下面是简单的门实例语句的格式。

```
gate_type[instance_name] (term1, term2, . . . , termN
```

注意，*instance\_name* 是可选的；*gate\_type* 为前面列出的某种门类型。各 *term* 用于表示与门的输入/输出端口相连的线网或寄存器。

同一门类型的多个实例能够在在一个结构形式中定义。语法如下：

```
gate_type
    [instance_name1] (term11, term12, . . . , term1N
    [instance_name2] (term21, term22, . . . , term2N
    . . .
    [instance_nameM] (termM1, termM2, . . . , termMN
```

### 5.2 多输入门

内置的多输入门如下：

**and nand nor or xor xnor**

这些逻辑门只有单个输出，1 个或多个输入。多输入

门实例语句的语法如下：

```
multiple_input_gate_type
    [instance_name] (OutputA, Input1, Input2, . . . , InputN
```

第一个端口是输出，其它端口是输入。如图 5-1 所示。

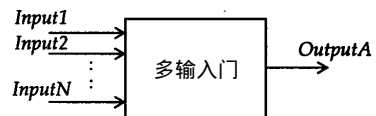


图 5-1 多输入门

下面是几个具体实例。图 5-2 为对应的逻辑图。

```
and A1(Out1, In1, In2);

and RBX (Sty, Rib, Bro, Qit, Fix);

xor (Bar, Bud[0], Bud[1], Bud[2]),
    (Car, Cut[0], Cut[1]),
    (Sar, Sut[2], Sut[1], Sut[0], Sut[3]);
```

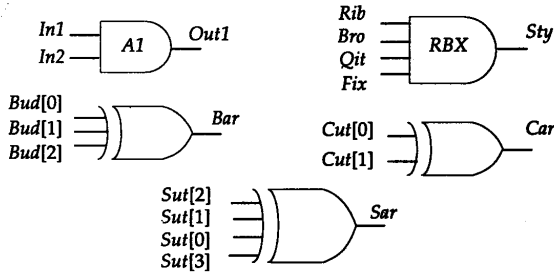


图5-2 多输入门实例

第一个门实例语句是单元名为 *A1*、输出为 *Out1*、并带有两个输入 *In1* 和 *In2* 的两输入与门。第二个门实例语句是四输入与门，单元名为 *RBX*，输出为 *Sty*，4 个输入为 *Rib*、*Bro*、*Qit* 和 *Fix*。第三个门实例语句是异或门的具体实例，没有单元名。它的输出是 *Bar*，三个输入分别为 *Bud[0]*、*Bud[1]* 和 *Bud[2]*。同时，这一个实例语句中还有两个相同类型的单元。

下面是这些门的真值表。注意在输入端的 *z* 与对 *x* 的处理方式相同；多输入门的输出决不能是 *z*。

nand	0	1	x	z	and	0	1	x	z
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	x	x	1	0	1	x	x
x	1	x	x	x	x	0	x	x	x
z	1	x	x	x	z	0	x	x	x

or	0	1	x	z	nor	0	1	x	z
0	0	1	x	x	0	1	0	x	x
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
x	x	1	x	x	x	x	0	x	x
z	x	1	x	x	z	x	0	x	x

xor	0	1	x	z	xnor	0	1	x	z
0	0	1	x	x	0	1	0	x	x
1	1	0	x	x	1	0	1	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z	x	x	x	x	z	x	x	x	x

### 5.3 多输出门

多输出门有：

```
buf not
```

这些门都只有单个输入，一个或多个输出。如图 5-3 所示。这些门的实例语句的基本语法如下：

```
multiple_output_gate_type
    [instance_name] (Out1, Out2, . . . OutN , InputA
```

最后的端口是输入端口，其余的所有端口为输出端口。

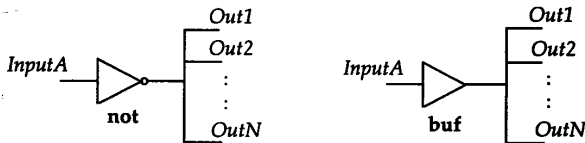


图5-3 多输出门

例如：

```
buf B1 (Fan [0], Fan [1], Fan [2], Fan [3], Clk);
not N1 (PhA, PhB, Ready);
```

在第一个门实例语句中，*Clk*是缓冲门的输入。门*B1*有4个输出：*Fan*[0]到*Fan*[3]。在第二个门实例语句中，*Ready*是非门的唯一输入端口。门*N1*有两个输出：*PhA*和*PhB*。

这些门的真值表如下：

buf	0	1	x	z	not	0	1	x	z
(输出)	0	1	x	x	(输出)	1	0	x	x

### 5.4 三态门

三态门有：

```
bufif0 bufif1 notif0 notif1
```

这些门用于对三态驱动器建模。这些门有一个输出、一个数据输入和一个控制输入。三态门实例语句的基本语法如下：

```
tristate_gate[instance_name] (OutputA, InputB, ControlC
```

第一个端口 *OutputA* 是输出端口，第二个端口 *InputB* 是数据输入，*ControlC* 是控制输入。参见图 5-4。根据控制输入，输出可被驱动到高阻状态，即值 *z*。对于 *bufif0*，若通过控制输入为 1，则输出为 *z*；否则数据被传输至输出端。对于 *bufif1*，若控制输入为 0，则输出为 *z*。对于 *notif0*，如果控制输出为 1，那么输出为 *z*；否则输入数据值的非传输到输出端。对于 *notif1*，若控制输入为 0；则输出为 *z*。

例如：

```
bufif1 BF1 (Dbus, MemData, Strobe);
notif0 NT2 (Addr, Abus, Probe);
```

当 *Strobe* 为 0 时，*bufif1* 门 *BF1* 驱动输出 *Dbus* 为高阻；否则 *MemData* 被传输至 *Dbus*。在第 2 个实例语句中，当 *Probe* 为 1 时，*Addr* 为高阻；否则 *Abus* 的非传输到 *Addr*。

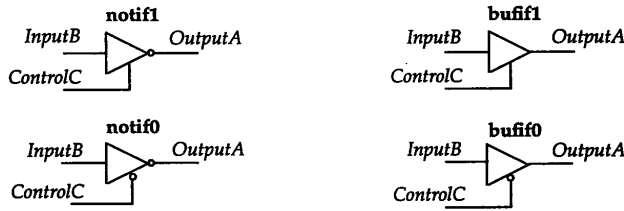


图5-4 三态门

下面是这些门的真值表。表中的某些项是可选项。例如，0/z表明输出根据数据的信号强度和 控制值既可以为0也可以为z，信号强度在第10章中讨论。

buff0		控制			
		0	1	x	z
数据	0	0	z	0/z	0/z
	1	1	z	1/z	1/z
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

buff1		控制			
		0	1	x	z
数据	0	z	0	0/z	0/z
	1	z	1	1/z	1/z
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

notif0		控制			
		0	1	x	z
数据	0	1	z	1/z	1/z
	1	0	z	0/z	0/z
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

notif1		控制			
		0	1	x	z
数据	0	z	1	1/z	1/z
	1	z	0	0/z	0/z
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

### 5.5 上拉、下拉电阻

上拉、下拉电阻有：

```
pullup      pulldown
```

这类门设备没有输入只有输出。上拉电阻将输出置为 1。下拉电阻将输出置为 0。门实例语句形式如下：

```
pull_gate[instance_name] (OutputA);
```

门实例的端口表只包含 1 个输出。例如：

```
pullup PUP (Pwr);
```

此上拉电阻实例名为 PUP，输出 Pwr 置为高电平 1。

### 5.6 MOS 开关

MOS 开关有：

```
cmos pmos nmos rcmos rpmos rnmos
```

这类门用来为单向开关建模。即数据从输入流向输出，并且可以通过设置合适的控制输入关闭数据流。

pmos(p类型MOS管)、nmos(n类型MOS管)，rnmos(r代表电阻)和rpmos开关有一个输出、一个输入和一个控制输入。实例的基本语法如下：

```
gate_type[instance_name] (OutputA, InputB, Control)G
```

第一个端口为输出，第二个端口是输入，第三个端口是控制输入端。如果 nmos和rnmos开关的控制输入为0，pmos和rpmos开关的控制为1，那么开关关闭，即输出为z；如果控制是1，输入数据传输至输出；如图 5-5所示。与nmos和pmos相比，rnmos和rpmos在输入引线和输出引线之间存在高阻抗(电阻)。因此当数据从输入传输至输出时，对于 rpmos和rmos，存在数据信号强度衰减。信号强度将在第 10章进行讲解。

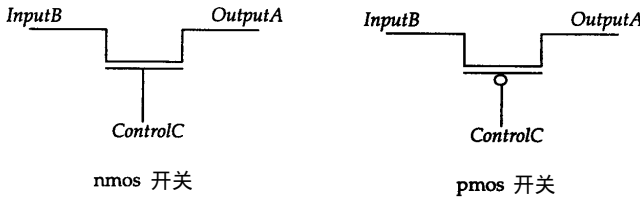


图5-5 nmos和pmos开关

例如：

```
pmos P1 (BigBus, SmallBus, GateControl)
rnmos RN1 (ControlBit, ReadyBit, Hold)
```

第一个实例为一个实例名为 P1 的pmos开关。开关的输入为 SmallBus，输出为 BigBus，控制信号为 GateControl。

这些开关的真值表如下所示。表中的某些项是可选项。例如，1/z表明，根据输入和控制信号的强度，输出既可以为1，也可以为z。

		控制						控制			
		0	1	x	z			0	1	x	z
数据	0	0	z	0/z	0/z	数据	0	z	0	0/z	0/z
	1	1	z	1/z	1/z		1	z	1	1/z	1/z
	x	x	z	x	x		x	z	x	x	x
	z	z	z	z	z		z	z	z	z	z

cmos(mos求补)和rcmos(cmos的高阻态版本)开关有一个数据输出，一个数据输入和两个控制输入。这两个开关实例语句的语法形式如下：

```
(r)cmos [instance_name]
(OutputA, InputB, NControl, PControl);
```

第一个端口为输出端口，第二个端口为输入端口，第三个端口为n通道控制输入，第四个端口为是P通道控制输入。cmos(rcmos)开关行为与带有公共输入、输出的 pmos (rpmos) 和nmos(rnmos)开关组合十分相似。参见图 5-6。

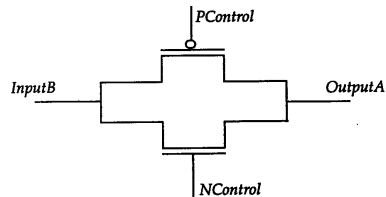


图5-6 (r)cmos开关

## 5.7 双向开关

双向开关有：

```
tran rtran tranif0 rtranif0 tranif1 rtranif1
```

这些开关是双向的，即数据可以双向流动，并且当数据在开关中传播时没有延时。后 4 个开关能够通过设置合适的控制信号来关闭。tran和rtran开关不能被关闭。

tran或rtran(tran 的高阻态版本)开关实例语句的语法如下：

```
(r)tran [instance_name] (SignalA, SignalB);
```

端口表只有两个端口，并且无条件地双向流动，即从 SignalA向SignalB，反之亦然。

其它双向开关的实例语句的语法如下：

```
gate_type[instance_name] (SignalA, SignalB, ControlC
```

前两个端口是双向端口，即数据从 SignalA流向SignalB，反之亦然。第三个端口是控制信号。如果对 tranif0和rtranif0，ControlC是1；对tranif1和rtranif1，ControlC是0；那么禁止双向数据流动。对于 rtran、rtranif0和rtranif1，当信号通过开关传输时，信号强度减弱。

## 5.8 门时延

可以使用门时延定义门从任何输入到其输出的信号传输时延。门时延可以在门自身实例语句中定义。带有时延定义的门实例语句的语法如下：

```
gate_type [delay][instance_name](terminal_list);
```

时延规定了门时延，即从门的任意输入到输出的传输时延。当没有强调门时延时，缺省的时延值为0。

门时延由三类时延值组成：

- 1) 上升时延
- 2) 下降时延
- 3) 截止时延

门时延定义可以包含 0个、1个、2个或3个时延值。下表为不同个数时延值说明条件下，各种具体的时延取值情形。

	无时延	1个时延(d)	2个时延(d1, d2)	3个时延 (dA, dB, dC)
上升	0	d	d1	dA
下降	0	d	d2	dB
to_x	0	d	min (d1, d2)	min (dA, dB, dC)
截止	0	d	min (d1, d2)	dC

min 是minimum 的缩写词。

注意转换到x的时延(to\_x)不但被显式地定义，还可以通过其它定义的值决定。

下面是一些具体实例。注意 Verilog HDL模型中的所有时延都以单位时间表示。单位时间与实际时间的关联可以通过`timescale编译器指令实现。在下面的实例中，

```
not N1 (Qbar, Q);
```

因为没有定义时延，门时延为0。下面的门实例中，

```
nand #6 (Out, In1, In2);
```

所有时延均为 6，即上升时延和下降时延都是 6。因为输出决不会是高阻态，截止时延不适用于与非门。转换到  $x$  的时延也是 6。

```
and #(3,5) (Out, In1, In2, In3;
```

在这个实例中，上升时延被定义为 3，下降时延为 5，转换到  $x$  的时延是 3 和 5 中间的最小值，即 3。在下面的实例中，

```
notif1 #(2,8,6) (Dout, Din1, Din2;
```

上升时延为 2，下降时延为 8，截止时延为 6，转换到  $x$  的时延是 2、8 和 6 中的最小值，即 2。

对多输入门（例如与门和非门）和多输出门（缓冲门和非门）总共只能定义 2 个时延（因为输出决不会是  $z$ ）。三态门共有 3 个时延，并且上拉、下拉电阻实例门不能有任何时延。

min:typ:max 时延形式

门延迟也可采用 *min:typ:max* 形式定义。形式如下：

```
minimum: typical: maximum
```

最小值、典型值和最大值必须是常数表达式。下面是在实例中使用这种形式的实例。

```
nand #(2:3:4, 5:6:7) Rout, Pin1, Pin2;
```

选择使用哪种时延通常作为模拟运行中的一个选项。例如，如果执行最大时延模拟，与非门单元使用上升时延 4 和下降时延 7。

程序块也能够定义门时延。程序块的定义和说明在第 10 章中讨论。

## 5.9 实例数组

当需要重复性的实例时，在实例描述语句中能够有选择地定义范围说明（范围说明也能够模块实例语句中使用）。这种情况的门描述语句的语法如下：

```
gate_type [delay]instance_name[leftbound:rightbound]
    (list_of_terminal_names);
```

*leftbound* 和 *rightbound* 值是任意的两个常量表达式。左界不必大于右界，并且左、右界两者都不必限定为 0。示例如下。

```
wire [3:0] Out, InA, InB
```

```
...
```

```
nand Gang [3:0] (Out, InA, InB);
```

带有范围说明的实例语句与下述语句等价：

```
nand
```

```
    Gang3 (Out[3], InA[3], InB[3]),
```

```
    Gang2 (Out[2], InA[2], InB[2]),
```

```
    Gang1 (Out[1], InA[1], InB[1]),
```

```
    Gang0 (Out[0], InA[0], InB[0]);
```

注意定义实例数组时，实例名称是不可选的。

## 5.10 隐式线网

如果在 Verilog HDL 模型中一个线网没有被特别说明，那么它被缺省声明为 1 位线网。但是 `default_nettype` 编译指令能够用于取代缺省线网类型。编译指令格式如下：

```
`default_nettype net_type
```

例如：

```
`default_nettype wand
```

根据此编译指令，所有后续未说明的线网都是 **wand** 类型。

``default_nettype` 编译指令在模块定义外出现，并且在下一个相同编译指令或 ``resetall` 编译指令出现前一直有效。

## 5.11 简单示例

下面是图 5-7 中 4-1 多路选择电路的门级描述。注意因为实例名是可选的（除用于实例数组情况外），在门实例语句中没有指定实例名。

```
module MUX4x1 (Z,D0,D1,D2,D3,S0,S1);
  output Z;
  input D0,D1,D2,D3,S0,S1;

  and (T0,D0,S0bar,S1bar),
      (T1,D1,S0bar,S1),
      (T2,D2,S0,S1bar),
      (T3,D3,S0,S1),

  not (S0bar,S0),
      (S1bar,S1);

  or (Z,T0,T1,T2,T3);
endmodule
```

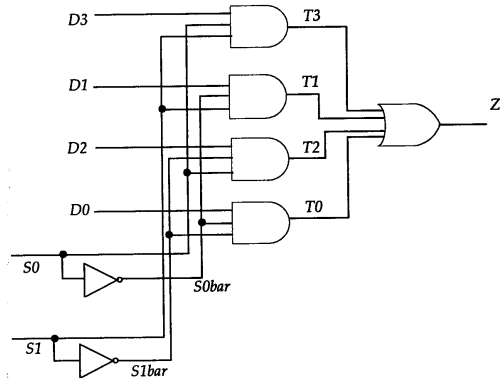


图5-7 4-1多路选择电路

如果或门实例由下列的实例代替呢？

```
or Z (Z,T0,T1,T2,T3); //非法的Verilog HD表达式。
```

注意实例名还是 Z，并且连接到实例输出的线网也是 Z。这种情况在 Verilog HDL 中是不允许的。在同一模块中，实例名不能与线网名相同。

## 5.12 2-4 解码器举例

图 5-8 中显示的 2-4 解码器电路的门级描述如下：

```
module DEC2x4 (A,B,Enable,Z);
  input A,B,Enable;
  output [0:3] Z;
  wire Abar, Bbar;

  not # (1,2)
    V0 (Abar,A),
    V1 (Bbar,B);

  nand # (4,3)
    N0 (Z[3], Enable, A,B),
    N1 (Z[0], Enable, Abar,Bbar),
    N2 (Z[1], Enable, Abar,B),
    N3 (Z[2], Enable, A,Bbar);
endmodule
```





```

xor # (5,4)
  XE0 (E0,D[0],D[1]),
  XE1 (E1,D[2],D[3]),
  XE2 (E2,D[4],D[5]),
  XE3 (E3,D[6],D[7]),
  XF0 (F0,E0,E1),
  XF1 (F1,E2,E3),
  XH0 (H0,F0,F1),
  XEVEN (Even, D[8], H0);
not #2
  XODD (Odd, Even);
endmodule

```

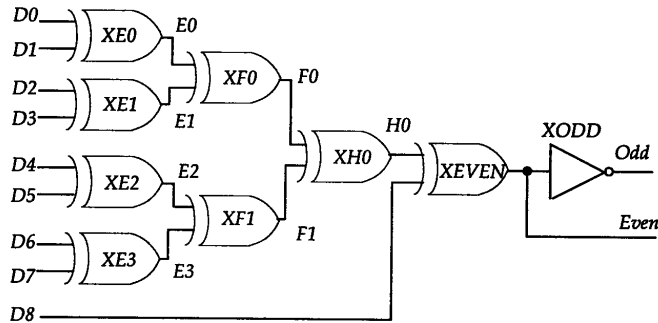


图5-10 奇偶发生器

## 习题

1. 用基本门描述图 5-11 显示的电路模型。编写一个测试验证程序用于测试电路的输出。使用所有可能的输入值对电路进行测试。
2. 使用基本门描述如图 5-12 所示的优先编码器电路模型。当所有输入为 0 时，输出 *Valid* 为 0，否则输出为 1。并且为验证优先编码器的模型行为编写测试验证程序。

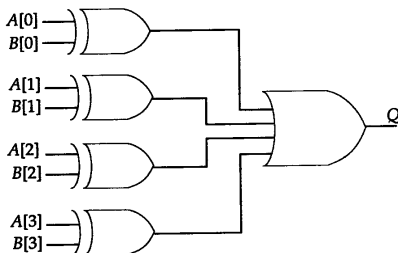


图5-11 A 不等于 B 的逻辑

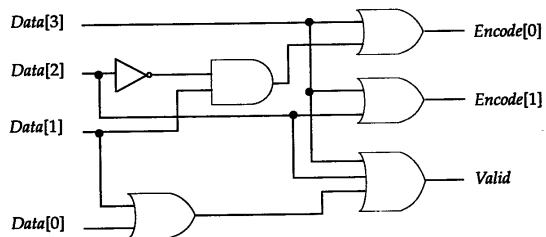


图5-12 优先编码器